

性能特点:

- 频率范围: 2.3GHz
- 输出功率: P1dB=35.5dBm (Typ.)
- 功率增益: G1dB=11.5dB (Min.)
- 效率: PAE≥46%
- 封装形式: QF061

产品简介:

NC41160S-2 是一种 GaAs 微波功率场效应晶体管, 用于 5GHz 以下微波系统中, 提供优良的功率和增益性能。

电参数 (T_C=+25°C)

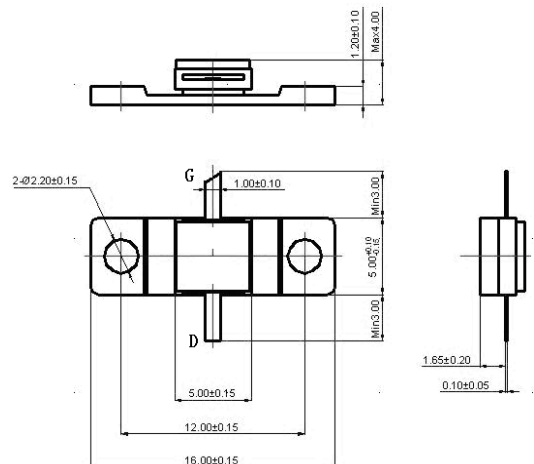
参数名称	符号	测试条件	极限值			单位
			最小	典型	最大	
饱和电流	I _{DSS}	V _{DS} =5V, V _{GS} =0V	-	1700	-	mA
夹断电压	V _{GS(off)}	V _{DS} =5V, I _{DS} =60mA	-3.5	-2.3	-1	V
跨导	g _m	V _{DS} =5V, V _{GS} =0, -1V	-	680	-	mS
栅源击穿电压	V _{GSO}	I _{GS} =-60uA	-	-	-5	V
1dB 压缩点输出功率	P1dB	f ₀ =2.3GHz V _{DS} =10V I _{DS} =0.6I _{DSS} (典型)	34.5	35.5	-	dBm
1dB 压缩点功率增益	G1dB		11.5	-	-	dB
功率附加效率	PAE		-	46	-	%
热阻	R _{th(j-c)}	V _{DS} =10V, I _{DS} =900mA	-	-	10	°C/W

使用限制参数

源漏电压	+15V
耗散功率 (T _C =25°C)	15W
储存温度	-65°C ~ +175°C
沟道温度	175°C

外形尺寸

QF061 管壳外形尺寸图 (mm)


注意事项:

- 1) 加电时请严格按先负后正的次序;
- 2) 注意使用过程中的散热, 壳温越低, 器件使用寿命越长;
- 3) 推荐器件工作壳温不超过 75°C, 过高会导致器件性能恶化, 缩短使用寿命;
- 4) 在使用过程中, 仪器、设备等应接地良好; 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电。